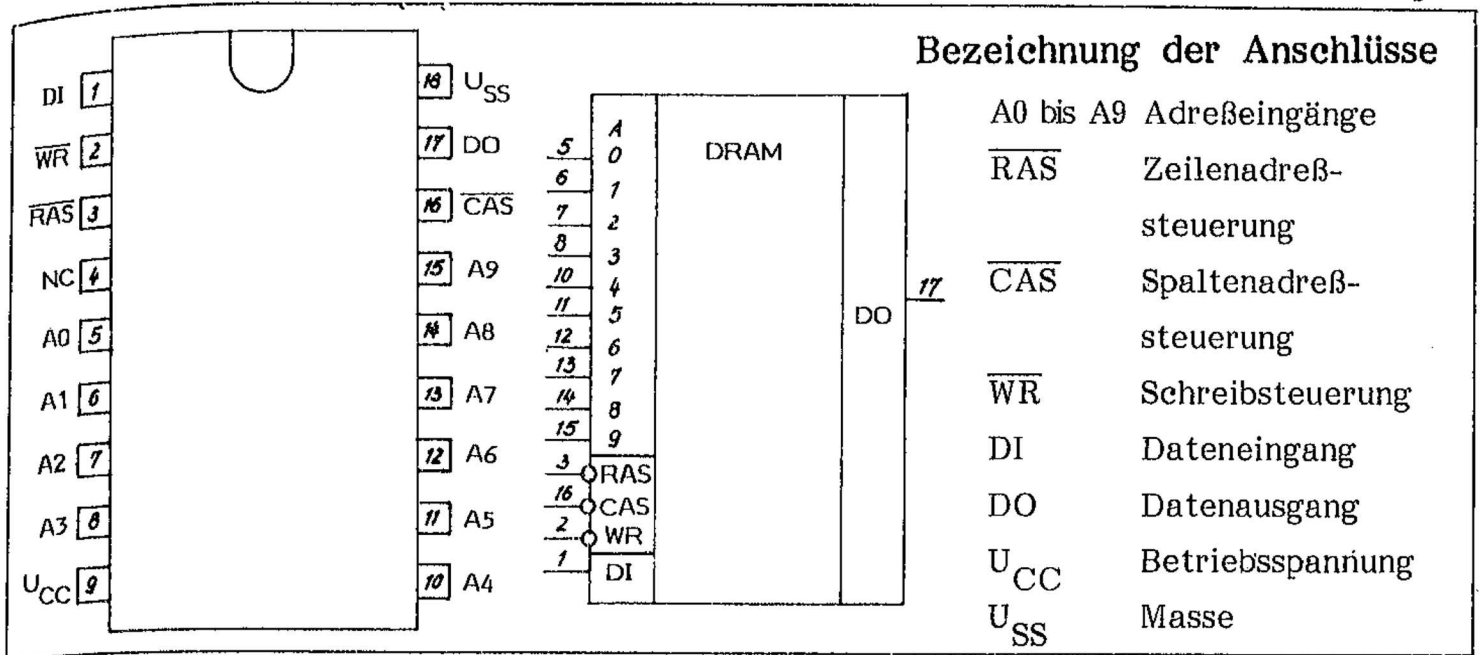


# U 61000 DC

## Dynamischer CMOS RAM 1 MBit x 1

\* In Entwicklung \*



Anschlußbelegung und Schaltzeichen

Typstandard: MDS 108

Bauform: DIP-18, Plast (Bild 6)

### Eigenschaften

- Speicherorganisation:  
1.048.576 x 1 Bit,
- hohe Arbeitsgeschwindigkeit,  
geringe Verlustleistung,
- TTL- und CMOS-Kompatibilität  
der Ein- und Ausgänge,
- Tristate-Ausgangsstufen,
- Betriebsspannung: 5 V  $\pm$  10 %,
- 512 Refreshzyklen; Refreshzeit 8 ms,

- Betriebs- und Refresharten:  
READ CYCLE,  
EARLY WRITE CYCLE,  
READ-WRITE CYCLE,  
FAST PAGE MODE CYCLE (READ und WRITE),  
FAST PAGE READ-WRITE CYCLE,  
 $\overline{\text{RAS}}$  ONLY REFRESH CYCLE,  
 $\overline{\text{CAS}}$  BEFORE  $\overline{\text{RAS}}$  REFRESH CYCLE,  
HIDDEN REFRESH CYCLE (READ und WRITE),  
 $\overline{\text{CAS}}$  BEFORE  $\overline{\text{RAS}}$  COUNTER TEST CYCLE.

### Ausgewählte Kennwerte

	U 61000 DC 12 Grundtyp	U 61000 DC 10 Selektionstyp
$\overline{\text{RAS}}$ -Zugriffszeit	120 ns	100 ns
$\overline{\text{CAS}}$ -Zugriffszeit	45 ns	35 ns
FPM-Zugriffszeit	60 ns	50 ns
Zykluszeit	220 ns	190 ns
FPM-Zykluszeit	70 ns	55 ns
Betriebsspannung	4,5 bis 5,5 V	
Betriebsstrom	max. 50 mA	max. 60 mA
Ruhestrom bei CMOS-Pegel	max. 1 mA	
bei TTL-Pegel	max. 2 mA	
Betriebstemperaturbereich	0 bis 70 °C	

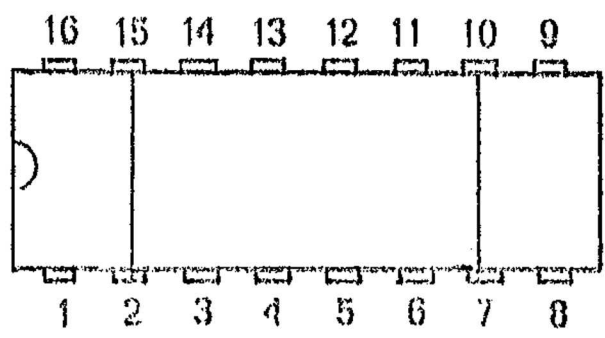
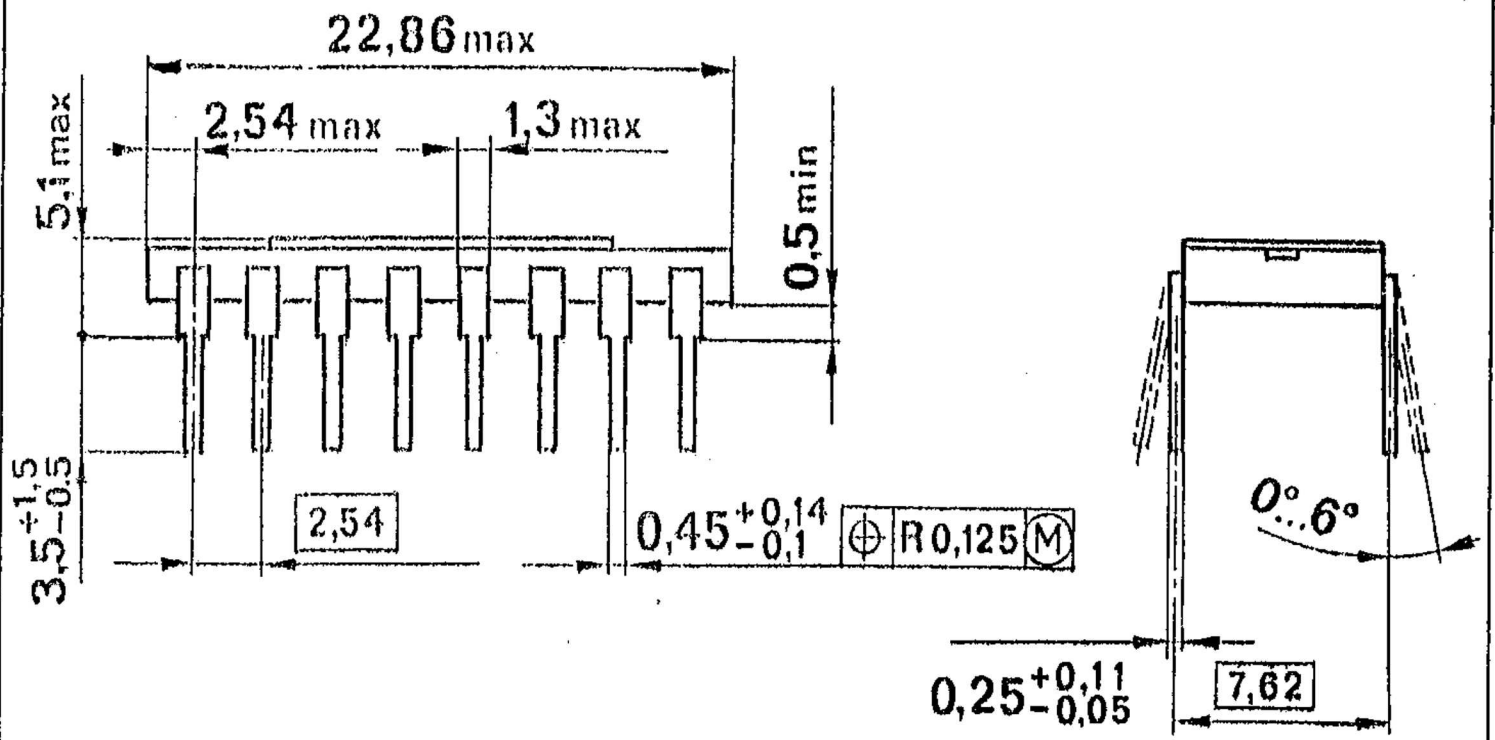


Bild 5 (DIP-16, Keramik)

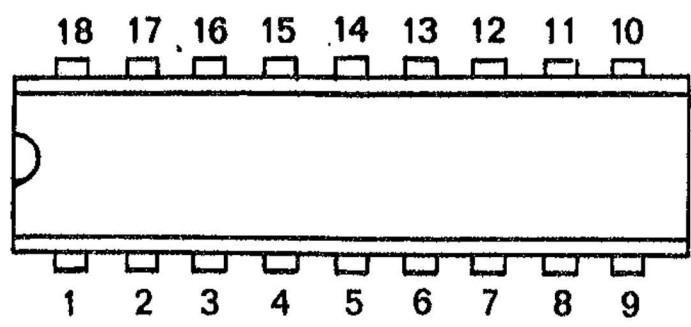
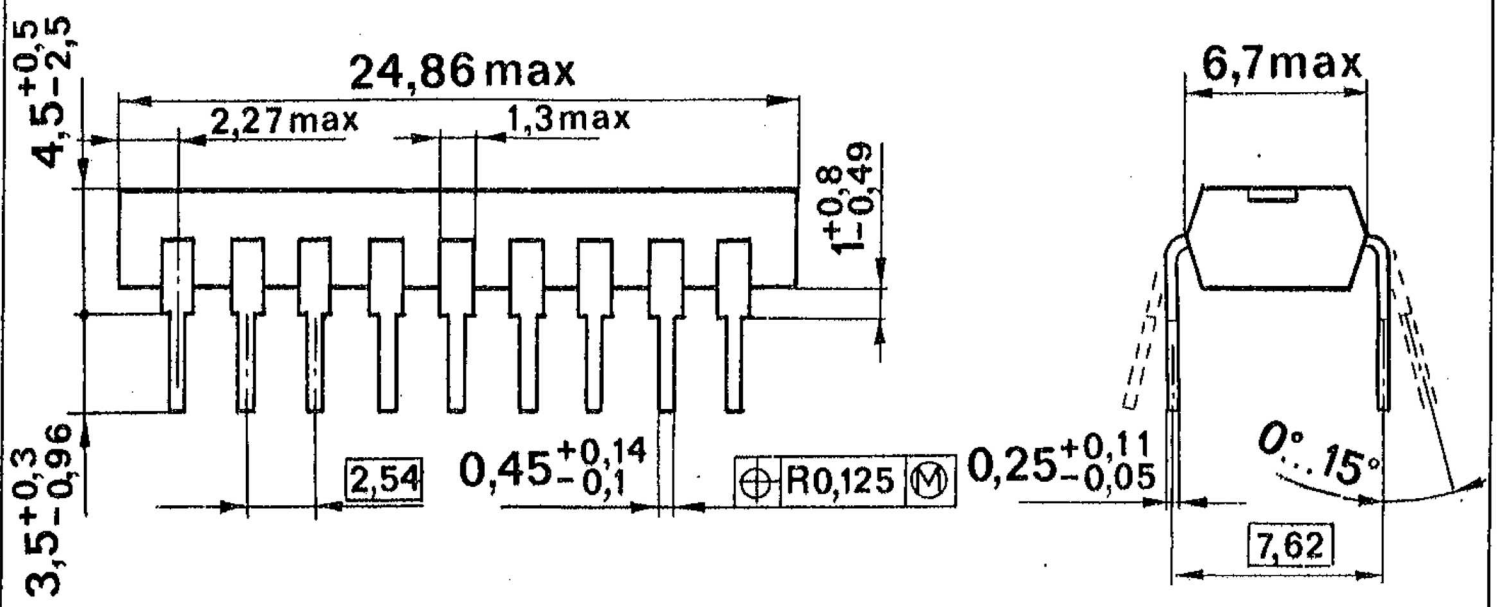


Bild 6 (DIP-18, Plast)